

Transistor Mosfet Irf3205 55 V 110 A

Codigo: **112766**



Descripción

El transistor Irf3205 es un MOSFET de canal N de energía HEXFET® con muy baja resistencia por unidad de superficie de silicio y de rendimiento de conmutación rápida que utiliza técnicas avanzadas de procesamiento para lograr muy baja resistencia por unidad de superficie de silicio. Este beneficio, en combinación con la velocidad de conmutación rápida y el diseño del dispositivo robusto que HEXFET MOSFET de potencia son bien conocidos por, ofrece al diseñador de un dispositivo extremadamente eficiente y fiable para uso en una amplia variedad de aplicaciones. El Irf3205 recomendado para aplicaciones industriales por su alto nivel de disipación que aproximan a los 50 watts.

• Clasificación dv/dt dinámica

- Clasificado avalancha completa
- Conmutación rápida
- Voltaje de compuerta a fuente de $\pm 20V$

Aplicaciones: Administración de potencia

- Polaridad de transistor: Canal N
- Voltaje de drenaje a fuente VDS: 55 V
- Voltaje de puerta a fuente VGS: ± 20 V
- Voltaje de drenaje a puerta VDGR: 55 V
- Corriente continua de drenaje ID: 110 A
- Corriente de drenaje pulsada IDP: 390 A
- Corriente de avalancha IAR: 62 A
- Disipación de potencia máxima PD: 200 W
- Resistencia VGS RDS(on) máximo: 0.008 Ω
- Temperatura de operación mínima: -55 °C
- Temperatura de operación máxima: 175 °C
- Encapsulado: TO-220
- Número de pines: 3

Sustituto

- NTE2991